

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 5 月 25 日 (2006.5.25)

【公開番号】特開 2004-282060 (P2004-282060A)

【公開日】平成 16 年 10 月 7 日 (2004.10.7)

【年通号数】公開・登録公報 2004-039

【出願番号】特願 2004-53312 (P2004-53312)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/268 (2006.01)

H 0 1 S 3/00 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/20

H 0 1 L 21/268 G

H 0 1 S 3/00 B

H 0 1 L 29/78 6 2 7 G

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 3 月 28 日 (2006.3.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】レーザ照射方法および結晶性半導体膜の作製方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

可視光線以下の波長である連続発振の第 1 のレーザビームを照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の第 2 のレーザビームを前記第 1 のレーザビームと重ねて同時に照射し、

前記第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 2】

可視光線以下の波長である連続発振の第 1 のレーザビームを照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の第 2 のレーザビームのエネルギー密度の高い部分を前記第 1 のレーザビームと重ねて同時に照射し、

前記第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 3】

可視光線以下の波長である連続発振の複数の第 1 のレーザビームを互いにつなげ、照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の第 2 のレーザビームを前記複数の第 1 のレーザビームと重ねて同時に照射し、

前記複数の第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 4】

可視光線以下の波長である連続発振の複数の第 1 のレーザビームを互いにつなげ、照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の第 2 のレーザビームのエネルギー密度の高い部分を前記複数の第 1 のレーザビームと重ねて同時に照射し、前記複数の第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 5】

可視光線以下の波長である連続発振の第 1 のレーザビームを照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の複数の第 2 のレーザビームを前記第 1 のレーザビームの両側にそれぞれ重ねて同時に照射し、前記第 1 のレーザビーム及び前記複数の第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 6】

可視光線以下の波長である連続発振の第 1 のレーザビームを照射面において楕円状ビームとなるように加工し、基本波である連続発振の複数の第 2 のレーザビームのエネルギー密度の高い部分を前記第 1 のレーザビームの両側にそれぞれ重ねて同時に照射し、前記第 1 のレーザビーム及び前記複数の第 2 のレーザビームと、前記照射面とを相対的に移動しながら照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、前記第 1 のレーザビームのエネルギー密度より高いエネルギー密度を有する前記第 2 のレーザビームを重ねて同時に照射し、前記照射面に対して不連続なエネルギー密度となるように照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか一において、前記第 1 のレーザビームまたは前記第 2 のレーザビームは、気体レーザ、固体レーザまたは金属レーザから射出されることを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか一において、前記第 1 のレーザビームまたは前記第 2 のレーザビームは、A r レーザ、K r レーザ、C O₂ レーザ、Y A G レーザ、Y V O₄ レーザ、Y L F レーザ、Y A l O₃ レーザ、アレキサンドライトレーザ、T i：サファイヤレーザまたはヘリウムカドミウムレーザから射出されることを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 10】

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか一において、前記照射面は前記第 1 のレーザビームに対して透光性を有する厚さ d の基板に成膜された膜であり、前記楕円状ビームの長径または短径の長さを W とすると、前記第 1 のレーザビームの前記照射面に対する入射角度 は、

$$\arctan(W/2d)$$

を満たすことを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項 11】

非単結晶半導体膜を形成し、可視光線以下の波長を有する連続発振であって、楕円状に加工された第 1 のレーザビームと、基本波を有する連続発振の第 2 のレーザビームとを重ねて同時に、前記非単結晶半導体膜に照射する結晶性半導体膜の作製方法であって、前記第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと前記非単結晶半導体膜とを相対的に第 1 の方向に移動させながら、前記第 1 のレーザビームと前記第 2 のレーザビームとを同時に、前記非単結晶半導体膜に照射して前記第 1 の方向と垂直な方向に配列された、長

結晶粒領域と、前記長結晶粒領域の両側の第 1 及び第 2 の結晶性不良領域とを形成し、
前記第 1 の方向に直交する第 2 方向に、前記長結晶粒領域及び前記第 1 の結晶性不良領域
の幅分を移動させることを特徴とする結晶性半導体膜の作製方法。

【請求項 1 2】

非単結晶半導体膜を形成し、

可視光線以下の波長を有する連続発振であって、楕円状に加工された第 1 のレーザビーム
と、基本波を有する連続発振の第 2 のレーザビームのエネルギー密度の高い部分とを重ね
て同時に、前記非単結晶半導体膜に照射する結晶性半導体膜の作製方法であって、
前記第 1 のレーザビーム及び前記第 2 のレーザビームと前記非単結晶半導体膜とを相対的
に第 1 の方向に移動させながら、前記第 1 のレーザビームと前記第 2 のレーザビームとを
同時に、前記非単結晶半導体膜に照射して前記第 1 の方向と垂直な方向に配列された、長
結晶粒領域と、前記長結晶粒領域の両側の第 1 及び第 2 の結晶性不良領域とを形成し、
前記第 1 の方向に直交する第 2 方向に、前記長結晶粒領域及び前記第 1 の結晶性不良領域
の幅分を移動させることを特徴とする結晶性半導体膜の作製方法。

【請求項 1 3】

請求項 1 1 または請求項 1 2 において、

前記可視光線以下の波長である連続発振の複数の第 1 のレーザビームを互いにつなげ、前
記非単結晶半導体膜において楕円状ビームとなるように加工して、前記第 2 のレーザビー
ムと重ねて同時に、前記非単結晶半導体膜に照射することを特徴とする結晶性半導体膜の
作製方法。

【請求項 1 4】

請求項 1 1 または請求項 1 2 において、

前記基本波である連続発振の複数の第 2 のレーザビームを前記第 1 のレーザビームの両側
にそれぞれ重ねて同時に、前記非単結晶半導体膜に照射することを特徴とする結晶性半導
体膜の作製方法。

【請求項 1 5】

請求項 1 1 乃至請求項 1 4 のいずれか一において、

前記第 1 のレーザ発振器または前記第 2 のレーザ発振器は、気体レーザ、固体レーザまた
は金属レーザであることを特徴とする結晶性半導体膜の作製方法。

【請求項 1 6】

請求項 1 1 乃至請求項 1 4 のいずれか一において、

前記第 1 のレーザ発振器または前記第 2 のレーザ発振器は、A r レーザ、K r レーザ、C
O₂ レーザ、Y A G レーザ、Y V O₄ レーザ、Y L F レーザ、Y A l O₃ レーザ、アレキ
サンドライトレーザ、T i : サファイヤレーザまたはヘリウムカドミウムレーザであるこ
とを特徴とする結晶性半導体膜の作製方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 2】

上記発明の構成において、前記第 1 のレーザ発振器及び前記第 2 のレーザ発振器は、連続
発振の気体レーザ、固体レーザまたは金属レーザであることを特徴としている。前記気体
レーザとして、A r レーザ、K r レーザ、C O₂ レーザ等があり、前記固体レーザとして
、Y A G レーザ、Y V O₄ レーザ、Y L F レーザ、Y A l O₃ レーザ、アレキサンドライ
トレーザ、T i : サファイヤレーザ等があり、前記金属レーザとしてはヘリウムカドミウ
ムレーザが挙げられる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0029】

上記発明の構成において、前記第1のレーザービームまたは前記第2のレーザービームは、連続発振の気体レーザー、固体レーザーまたは金属レーザーから射出されたものであることを特徴としている。前記気体レーザーとして、Arレーザー、Krレーザー、CO₂レーザー等があり、前記固体レーザーとして、YAGレーザー、YVO₄レーザー、YLFレーザー、YAlO₃レーザー、アレキサンドライトレーザー、Ti：サファイヤレーザー等があり、前記金属レーザーとしてはヘリウムカドミウムレーザーが挙げられる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0037】

また、上記発明の構成において、前記第1のレーザービームまたは前記第2のレーザービームは、連続発振の気体レーザー、固体レーザーまたは金属レーザーから射出されたものであることを特徴としている。前記気体レーザーとして、Arレーザー、Krレーザー、CO₂レーザー等があり、前記固体レーザーとして、YAGレーザー、YVO₄レーザー、YLFレーザー、YAlO₃レーザー、アレキサンドライトレーザー、Ti：サファイヤレーザー等があり、前記金属レーザーとしてはヘリウムカドミウムレーザーが挙げられる。